スピン偏極 STM によるナノスケール磁気特性の開拓

岡 博文

東北大学材料科学高等研究所(AIMR)

Magnetic Properties at the nanoscale: Spin-polarized STM study Hirofumi Oka Advanced Institute for Materials Research (AIMR), Tohoku University

1990 年に Wiesendanger らにより、スピン偏極 STM の実験結果が初めて報告された[1]。それ 以来精力的にスピン偏極 STM 技術の開発が行われ、現在ではスピン偏極 STM はナノスケール での磁気特性を議論する上で欠かせない手法となっている。例えば、磁気スキルミオンの操作[2] やマヨラナ束縛状態の検出[3]、磁性単原子のスピン緩和時間の測定[4]などが可能となった。本 講演では、スピン偏極 STM の動作原理を説明し、講演者らがスピン偏極 STM をもとに開発した 新規手法や明らかにした結果を中心に、スピン偏極 STM を用いることによりどのような情報が得 られるのか紹介する。

図 1(a)に、Coアイランド[図 1(a)挿入図]の中心で測定 した微分コンダクタンス(dl/dV)の磁場依存性を示す[5]。 磁気トンネル接合でみられるようなヒステリシス曲線が 得られている。この測定結果から、Coアイランド個々の 磁化反転磁場の値が得られ、そのアイランドサイズ依 存性から磁化反転メカニズムを議論することができる[6]。 また、外部磁場により、スピン偏極 STM 探針と Coアイ ランドの相対磁化を平行または反平行配置に制御する ことができ、平行・反平行配置で得られた微分コンダク タンス像から図 1(b)のようなスピン偏極度のマッピング を行うことも可能となる[7]。

[1] Wiesendanger, et al., PRL 65, 247 (1990).

- [2] Romming, et al., Science 341, 636 (2013).
- [3] Nadj-Perge, et al., Science 346, 602 (2014).
- [4] Loth, et al., Science 329, 1628 (2010).
- [5] Rodary, Oka, et al., APL 95, 152513 (2009).



図 1: (a) Co アイランドの dl/dV ヒステ リシス曲線。(b) Co アイランドの dl/dV 非対称度(スピン偏極度)マップ。

[6] Ouazi, Oka, et al., PRL 108, 107206 (2012). Mishra, Oka, et al., Nano Lett. 17, 5843 (2017).

[7] Oka et al., Science 327, 843 (2010).